

Deposition Mechanism and Characterization of a-C:H Films Deposited using Ar + H₂ + C₇H₈ Plasma CVD

董, ?

<https://doi.org/10.15017/1654913>

出版情報：九州大学, 2015, 博士（学術）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済

(別紙様式 5 - 2)

氏 名	董 焜 DONG XIAO (トウ ショウ)
論 文 名	Deposition Mechanism and Characterization of a-C:H Films Deposited using Ar+H ₂ +C ₇ H ₈ Plasma CVD (Ar+H ₂ +C ₇ H ₈ プラズマCVDで形成したa-C:H薄膜の成長機構と特性評価)
論文調査委員	主査 九州大学 教授 白谷 正治 副査 九州大学 教授 岡田 龍雄 副査 九州大学 准教授 古閑 一憲

論文審査の結果の要旨

本研究は、Ar+H₂+C₇H₈ プラズマCVDを用いて100°Cの基板上に 40nm/min以上の堆積速度で膜密度1.92 g/cm³以上のダイヤモンド様a-C:H膜を作製することに成功したもので、極端紫外光源露光を用いたレジストパターンの脆弱性の課題解決に資する成果であり、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士(学術)の学位に値するものと認める。